Pomiary parametrów elementów RLC przy prądzie sinusoidalnym

Uzupełnienie do modelowania dwójników liniowych pasywnych i pomiarów ich parametrów w obwodach o prądzie sinusoidalnym

odniesione do treści zawartej w opisie ogólnym zagadnienia

Oznaczenia i zależności funkcyjne

Definicja:

• - zorientowany kąt przesunięcia fazowego mierzony pomiędzy położeniem wektora napięcia <u>U</u> występującego na dwójniku badanym a położeniem wektora prądu <u>I</u> w nim płynącego czyli kąt fazowy impedancji zespolonej <u>Z</u> tego dwójnika

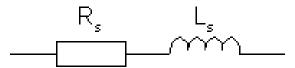
$$\underline{Z} = \underline{U/I} = Z \cdot \exp(j\varphi) \rightarrow 1/\underline{Z} = (1/Z) \cdot \exp(-j\varphi)$$
, w której:
moduł $Z = I\underline{Z}I$, argument $\varphi = \arctan(Im \underline{Z})/(Re \underline{Z})$, $\varphi = \alpha_U - \alpha_U$

Są rozpatrywane dwa podstawowe układy zastępcze każdego z dwójników rzeczywistych, które powinny być równoważne.

Standardowo cewkę indukcyjną rzeczywistą rozpatruje się przy założeniu szeregowego układu zastępczego definiując jej rezystancję szeregową R_s , indukcyjność szeregową L_s i stratność D_L .

Standardowo kondensator rzeczywisty rozpatruje się przy założeniu równoległego układu zastępczego definiując jego rezystancję równoległą R_p , pojemność równoległą C_p i stratność dielektryczną D_c .

Podstawowy model dwójnika indukcyjnego opisuje parametry podstawowego układu zastępczego cewki indukcyjnej rzeczywistej.



Impedancja zespolona modelu układu szeregowego cewki rzeczywistej

$$\begin{array}{ll} \underline{Z_s} = R_s + jX_s = R_s + jX_{Ls} = Z_s \bullet exp \ (j^\phi), \ której: \\ część rzeczywista jest rezystancją & Re \ \underline{Z}_s = R_s \\ część urojona jest reaktancją & Im \ \underline{Z}_s = X_s = X_{Ls} \\ ze składową reaktancją indukcyjną & X_{Ls} = \omega L_s = 2\pi f L_s \\ moduł & Z_s = I \underline{Z}_s I \ \rightarrow \ (Z_s)^2 = (R_s)^2 + (X_{Ls})^2 \\ argument & \phi = arctg \ (X_{Ls}/R_s) > 0 \end{array}$$

Admitancja zespolona modelu układu szeregowego cewki rzeczywistej

$$\begin{array}{ll} \underline{Y}_S = 1/\underline{Z}_S = 1/(R_S + jX_{LS}) = R_S/(Z_S)^2 + j(-X_{LS})/(Z_S)^2 = Y_S \bullet exp \ (-j\phi), \ której: \\ część rzeczywista jest konduktancją Re \underline{Y}_S = R_S/(Z_S)^2 \\ część urojona jest susceptancją Im \underline{Y}_S = (-X_{LS})/(Z_S)^2 \\ ze składową susceptancją indukcyjną X_{LS}/(Z_S)^2 \\ moduł Y_S = 1/Z_S = I\underline{Y}_SI \ \rightarrow \ (Y_S)^2 = (Re \underline{Y}_S)^2 + (Im \underline{Y}_S)^2 \\ argument \ (-\phi) = arctg \ (-X_{LS}/R_S) < 0 \end{array}$$

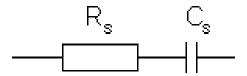
Admitancja zespolona modelu układu równoległego cewki rzeczywistej

 $\begin{array}{ll} \underline{Y}_p = G_p + jB_p = G_p + j(-B_{Lp}) = Y_p \bullet exp \ (-j^\phi), \ której: \\ część rzeczywista jest konduktancją & Re \ \underline{Y}_p = G_p = 1/R_p \\ część urojona jest susceptancją & Im \ \underline{Y}_p = B_p = -B_{Lp} \\ ze składową susceptancją indukcyjną & B_{Lp} = 1/X_{Lp} = 1/\omega L_p = 1/2\pi f L_p \\ moduł & Y_p = I \underline{Y}_p I \ \overrightarrow{\rightarrow} \ (Y_p)^2 = (G_p)^2 + (-B_{Lp})^2 \\ argument & (-\phi) = arctg \ (-B_{Lp}/G_p) = arctg \ (R_p/(-X_{Lp}) < 0) \end{array}$

Oba <u>układy zastępcze cewki indukcyjnej</u> są <u>równoważne</u> gdy $\underline{Y}_p = \underline{Y}_s$, czyli:

konduktancja $G_p = 1/R_p = R_s/(Z_s)^2$ susceptancja indukcyjna $B_{Lp} = 1/X_{Lp} = X_{Ls}/(Z_s)^2$ Dobroć $Q_L = X_{Ls}/R_s = \omega L_s/R_s = tg \ ^\phi \qquad oraz \quad Q_L = B_{Lp}/G_p = R_p/\omega L_p = tg \ ^\phi$ Stratność $D_L = R_s/X_{Ls} = R_s/\omega L_s \qquad oraz \quad D_L = G_p/B_{Lp} = \omega L_p/R_p$

Podstawowy model dwójnika pojemnościowego opisuje parametry podstawowego układu zastępczego kondensatora rzeczywistego.



Impedancja zespolona modelu układu szeregowego kondensatora rzeczywistego

 $\begin{array}{ll} \underline{Z_S} = R_S + jX_S = R_S + j(-X_{CS}) = Z_S \bullet \exp(j\phi), \ której: \\ \text{część rzeczywista jest rezystancją} & \text{Re } \underline{Z}_S = R_S \\ \text{część urojona jest reaktancją} & \text{Im } \underline{Z}_S = X_S = -X_{CS} \\ \text{ze składową reaktancją pojemnościową} & X_{CS} = 1/\omega C_S = 1/2\pi f C_S \\ \text{moduł} & Z_S = |\underline{Z}_S| \rightarrow (Z_S)^2 = (R_S)^2 + (-X_{CS})^2 \\ \text{argument} & \phi = \operatorname{arctg}(-X_{CS}/R_S) < 0 \end{array}$

Admitancja zespolona modelu układu równoległego kondensatora rzeczywistego

 $\begin{array}{ll} \underline{Y}_p = G_p + jB_p = G_p + jB_{Cp} = Y_p \bullet exp \ (-j^\phi), \ której: \\ część rzeczywista jest konduktancją & Re \ \underline{Y}_p = G_p = 1/R_p \\ część urojona jest susceptancją & Im \ \underline{Y}_p = B_p = B_{Cp} \\ ze składową susceptancją pojemnościową & B_{Cp} = 1/X_{Cp} = \omega C_p = 2\pi f C_p \\ moduł & Y_p = I\underline{Y}_pI \ \rightarrow \ (Y_p)^2 = (G_p)^2 + (B_{Cp})^2 \\ argument & (-\phi) = arctg \ (B_{Cp}/G_p) = arctg \ (R_p/X_{Cp}) > 0 \end{array}$

Impedancja zespolona modelu układu równoległego kondensatora rzeczywistego

$$\begin{split} \underline{Z}_p &= 1/\underline{Y}_p = 1/(G_p + jB_{Cp}) = G_p/(Y_p)^2 + j(-B_{Cp})/(Y_p)^2 = Z_p \bullet \exp(j^p), \text{ której:} \\ \text{część rzeczywista jest rezystancją} & \text{Re } \underline{Z}_p = G_p/(Y_p)^2 = 1/(Y_p)^2 R_p \\ \text{część urojona jest reaktancją} & \text{Im } \underline{Z}_p = (-B_{Cp})/(Y_p)^2 = 1/(Y_p)^2(-X_{Cp}) \\ \text{ze składową reaktancją pojemnościową} & \text{Bc}_p/(Y_p)^2 = 1/(Y_p)^2 X_{Cp} \\ \text{moduł} & Z_p = 1/Y_p = I\underline{Z}_pI \to (Z_p)^2 = (\text{Re } \underline{Z}_p)^2 + (\text{Im } \underline{Z}_p)^2 \end{split}$$

Pomiary parametrów elementów RLC przy prądzie sinusoidalnym

argument $\varphi = \operatorname{arctg} \left(-B_{Cp}/G_p \right) = \operatorname{arctg} \left[R_p/(-X_{Cp}) \right] < 0$

Oba układy zastępcze kondensatora są równoważne gdy $Z_s = Z_p$, czyli:

rezystancja $R_s = G_p/(Y_p)^2 = 1/(Y_p)^2 R_p$ reaktancja pojemnościowa $X_{Cs} = B_{Cp}/(Y_p)^2 = 1/(Y_p)^2 X_{Cp}$

Dobroć $Q_C = X_{Cs}/R_s = 1/\omega C_s R_s = tg \ I^{\phi}I$ oraz $Q_C = B_{Cp}/G_p = \omega C_p R_p = tg \ I^{\phi}I$ Stratność $D_C = R_s/X_{Cs} = \omega C_s R_s = tg \ \delta$ oraz $D_C = G_p/B_{Cp} = 1/\omega C_p R_p = tg \ \delta$

 $\delta = (\pi/2) - I^{\phi}I$ - kat strat dielektrycznych

Dane techniczne elementów układów pomiarowych

Podstawowe parametry wybranych przyrządów i proponowanych elementów układów pomiarowych:

Akustyczny generator o maksymalnym napięciu wyjściowym 0-15V, maksymalnej mocy wyjściowej 10W i rezystancji wyjściowej 6Ω jest źródłem sygnału sinusoidalnego.

Laboratoryjny multimetr cyfrowy DM o impedancji wejściowej $Z_{\text{we}} > 1 \text{M}\Omega$ i założonej niepewności pomiaru ΔU wyznaczanej z sumy 0,02% wartości mierzonej napięcia U i 0,02% używanego zakresu $U_{\text{zV}} = 4,000~00\text{V}$ lub 40,000V pełni również rolę częstościomierza.

Laboratoryjny woltomierz 4-cyfrowy, np. V541 o impedancji wejściowej $Z_{we} > 1M\Omega$ i niepewności pomiaru ΔU wyznaczanej z sumy 0,05% wartości mierzonej napięcia U i 0,05% używanego zakresu $U_{zV} = 1,000$ 0V lub 10,000V.

Mostek cyfrowy typu ELC-3131D równoważony automatycznie jest obsługiwany ręcznie przyciskami na jego płycie czołowej.

Mostek półautomatyczny elektroniczny, np. typu E314 z odczytem cyfrowym jest równoważony ręcznie przełącznikami i pokrętłami na jego płycie czołowej.

Niektóre elementy przewidziane do budowy mostka Wiena:

- generator o napięciu wyjściowym 0-15V jako źródło sygnału sinusoidalnego w pasmie akustycznym,
- transformator pomiarowy przystosowany do pracy w pasmie akustycznym,
- aktywny wskaźnik zera o regulowanym ręcznie wzmocnieniu i selektywnej charakterystyce czestotliwościowej przy 50Hz i 1kHz.
- kondensatory wzorcowe o niedokładności 0,05% i pojemności

 $C_N = 0.5 \mu F$ oraz tg $\delta_N = 0.003$ przy 1kHz,

 $C_N = 0.1 \mu F$ oraz tg $\delta_N = 0.001$ przy 1kHz,

 $C_N = 0.05 \mu F$ oraz tg $\delta_N = 0.003$ przy 1kHz.

kondensator dekadowy o pojemności

 $C_d = [(0_11)x1 + (0_11)x0,1 + (0_11)x0,01 + (0_11)x0,001 + (0_11)x0,000 \ 1]\mu F$ i niedokładności 0,1% oraz tg $\delta_d = 0,005$,

- kondensator dekadowy o pojemności C_d =[(0_11)x0,1+(0_11)x0,01+(0_11)x0,001+(0_11)x0,000 01+(0-100)x0,000 001]µF i niedokładności 0,1% oraz tg δ_d = 0,005.
- rezystory dekadowe 6 zakresowy i 5 zakresowy o niedokładności $\pm 0,1\%$ i o rozdzielczości odpowiednio $0,1\Omega$ i 1Ω

Dane rezystora dekadowego 5-zakresowego typu D-51: klasa 0,1						
Pozycja przełącznika obrotowego	0-10	0-10	0-9	0-9	0-9	0-9
Rezystancja znamionowa Ren jednego stopnia						
zakresu	Ω	10 000	1000	100	10	1
Dopuszczalna obciążalność prądowa I _{ed}						
jednego stopnia zakresu	mΑ	8	30	80	300	1 000

Pomiary metodą trzech woltomierzy

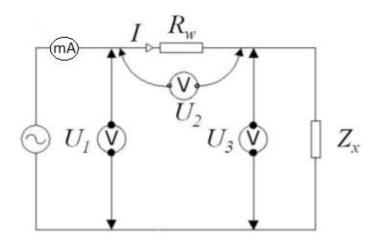
R_w – rezystancja regulowana opornika dekadowego o rozdzielczości 0,1Ω i niedokładności ±0,1%, rezystor ten powinien być połączony w układzie 4W z użyciem 4-ech zacisków, f – czestotliwość mierzona laboratoryjnym multimetrem cyfrowym DM,

 I_A <150mA – wartość prądu w układzie ustawiona na miliamperomierzu bezpośrednim, $I = U_2/R_W$ – wartość prądu w układzie wyznaczona metodą pośrednią,

 U_1 – napięcie mierzone laboratoryjnym multimetrem cyfrowym DM na zakresie $U_{zV} = 4,00\,000V$ lub 40,000V,

 U_2 , U_3 napięcie mierzone laboratoryjnym woltomierzem cyfrowym, np. V541 na zakresie $U_{zV} = 1,000 \text{ OV lub } 10,000\text{ V}$,

Z_x – impedancja badanego dwójnika RLC.



Pomiary mostkiem quasi-automatycznym cyfrowym, np. typu ELC-3131D

Pomiary parametrów kondensatora rzeczywistego zestawionym mostkiem Wiena równoważonym ręcznie

Mostek powinien być zestawiony zgodnie z projektem. Należy zaproponować schemat układu mostka Wiena pracującego przy częstotliwości 1kHz i dobrać parametry jego elementów składowych do pomiaru parametrów kondensatora rzeczywistego, element udostępniony:

??? nF o tolerancji $\pm y\%$ i tg $\delta_x = \sim 0.0zz$ przy 1kHz.

Kierując się dążeniem do spełnienia kryterium maksymalnej czułości układu i zapewnienia ustalonej minimalnej niepewności pomiaru pojemności należy przedstawić drogę postepowania przy projektowaniu mostka.

Wybierając kondensator wzorcowy o pojemności C_N oraz tg δ_N określonym przy 1kHz lub kondensator dekadowy o pojemności C_d oraz tg δ_d określonym przy 1kHz jako kondensator odniesienia (dokładny) C_2 należy odpowiednio zapewnić dwa warunki równowagi mostka obejmujące równoważenie modułu i fazy, układy równań (12) i (13) podane w opisie ogólnym zagadnienia. W konsekwencji należy zapewnić spełnienie układu równań (14) przy zachowaniu równania (15) poprzez ustawienie odpowiedniej wartości rezystancji R_{d2} dodatkowego rezystora dekadowego aby w stanie równowagi

 $R_2 = R_N + R_{d2}$ lub $R_2 = R_{d}$, + R_{d2} , gdzie:

 R_N = rezystancja strat mocy kondensatora C_N obliczona na postawie tg δ_N przy 1kHz R_d = rezystancja strat mocy kondensatora C_d obliczona na postawie tg δ_d przy 1kHz Poprzez zwiększenie rozdzielczości rezystora równoważącego R_d zapewnia się wymaganą rozdzielczość pomiaru pojemności zwykle ze stratą na czułości układu mostka.

Pomiary mostkiem Wiena półautomatycznym elektronicznym, np. typu E314.

Niepewność wyników pomiarów

W układach mostkowych niepewność ta jest określona niedokładnościa elementów wzorcowych (błąd systematyczny), czułością mostka (błąd nieczułości) oraz wpływami czynników pasożytniczych (sprzężenia pojemnościowe, upływności doziemne, rezystancje przewodów łączących i zestyków). Spośród czynników pasożytniczych, najsilniej wpływających na niedokładność pomiaru, należy wymienić sprzężenia pojemnościowe. Każdy element mostka, włączając tu także źródło zasilania i wskaźnik zera, ma pewną pojemność względem ziemi i innych elementów. Przy zasilaniu układów mostkowych ze źródeł o czestotliwości sieci energetycznej 50 Hz lub źródeł o czestotliwościach rzedu kilkaset do kilku tysięcy Hz, można przyjąć, że pojemności sprzężeń są stałymi skupionymi. Podstawowym środkiem stosowanym do ograniczania wpływu sprzeżeń pojemnościowych jest ekranowanie. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie tak pojedvnozvch jak i podwójnych ekranów nie usuwa sprzeżeń. Jecz tylko ustala jch wartości. Spośród kilku metod eliminacji wpływu przewodności doziemnych zasługuje na szczególną uwagę metoda gałęzi pomocniczej Wagnera, pozwalająca na usunięcie wpływu wszystkich sprzężeń oddziałujących na wynik pomiaru [1]. Błąd systematyczny graniczny wyznaczany jest najczęściej drogą obliczenia różniczki zupełnej wzoru określającego wielkość mierzoną. Przy szacowaniu błędu granicznego dobre wyniki daje metoda podstawienia. Polega ona na wykonaniu dwóch pomiarów. Oprócz pomiaru właściwego, tj. pomiaru parametrów badanego elementu, należy wykonać pomiar pomocniczy wzorca o parametrach zbliżonych do parametrów badanego elementu. Prosta analiza pokazuje, że w ten sposób możemy niepewność wyniku bardzo przybliżyć

Błędy popełnione przy pomiarach bezpośrednich w metodzie trzech woltomierzy $\delta_{U1\%}$ $\delta_{U2\%}$ $\delta_{U3\%}$

powinny być obliczone zgodnie z ich definicją przy wykorzystaniu specyfikacji podanej przez producenta użytych przyrządów.

Do obliczeń błędów popełnianych przy pomiarach pośrednich w tej metodzie, jak $\delta_{1\%}$ $\delta_{7s\%}$ $\delta_{Rs\%}$ $\delta_{xs\%}$ $\delta_{xs\%}$ $\delta_{xs\%}$

 $\delta_{l\%}$ $\delta_{Zs\%}$ $\delta_{Rs\%}$ $\delta_{XLs\%}$ $\delta_{Ls\%}$ są zalecane metody logarytmiczna i różniczki zupełnej. Zwykle należy przeprowadzić stosowne obliczenia i przedstawić ich przykłady, porównać osiągnięte wyniki badań poparte analiza dokładnościowa.

Literatura

do niepewności wzorca.

- [1] Hague B. Foord T.R.: Alternating Current Bridge Methods, 6 ed. Pitman Publishing 1971
- [2] Karandiejew K. B.: Pomiary elektryczne metodami mostkowymi i kompensacyjnymi, (tłum. z ros.), Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 1969
- [3] Karandiejew K.B.(red.): Transformatornyje izmeritelnyje mosty, Energia, Moskwa 1970
- [4] Szulce A.: Mostki elektryczne pomiarowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1977
- [5] Stabrowski M. M.: Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002